

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

4-е заседание Председатель – Терещенко О.Е.

9⁰⁰ – 9³⁰

С.А.Бабин^{1,2}, М.И.Скворцов¹, А.А.Вольф¹,
А.В.Достовалов¹, С.Р.Абдуллина¹, А.А.Власов¹.

Волоконные лазеры с распределенной обратной связью на основе регулярных и случайных структур показателя преломления (**приглашенный доклад**)(*on-line*).

¹ Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск;

² Новосибирский государственный университет, Новосибирск. А.В.Галеева¹, А.С.Казаков¹,
А.И.Артёмкин¹,

9³⁰ – 9⁴⁵

Н.Н.Михайлов¹, С.А.Дворецкий^{1,3}, Р.В.Меньшиков¹,
В.Г.Ремесник¹, И.Н.Ужаков¹, В.А.Швец^{1,2}.

МЛЭ рост сложных фотоприёмных, лазерных и nВn структур на основе твердых растворов CdHgTe.

¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;

³ Томский государственный университет, Томск.

9⁴⁵ – 10⁰⁰

И.И.Кремис, Р.А.Гладков, А.С.Турбин, Е.А.Крапивко,
П.А.Алдохин, В.С.Калинин, В.В.Васильев,
А.А.Моисеев.

Малогабаритная тепловизионная камера с микросканированием на базе отечественного матричного КРТ фотоприемника.

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ».

10⁰⁰ – 10¹⁵

В.А.Голяшов^{1,2}, Д.А.Кустов¹, В.С.Русецкий^{2,3},
Т.С.Шамирзаев^{1,2}, А.В.Миронов², А.Ю.Демин²,
В.В.Аксенов², О.Е.Терещенко^{1,2}.

Оптический детектор спина свободных электронов с пространственным разрешением на основе полупроводниковых гетероструктур.

¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;

$10^{15} - 10^{30}$	<p>³ ЗАО "ЭКРАН-ФЭП", Новосибирск. <u>С.А.Кузнецов</u>^{1,2}, А.В.Гельфанд¹, П.А.Лазорский¹, В.Н.Федоринин¹, А.В.Аржанников^{2,3}, Н.А.Николаев^{2,4}, А.А.Мамрашев⁴, А.А.Рыбак^{2,4}, А.Н.Генцелев³, В.П.Бессмельцев⁴.</p> <p>Высокоэффективные квазиоптические частотные фильтры ТГц диапазона на основе частотно-избирательных поверхностей.</p> <p>¹ Новосибирский филиал ИФП СО РАН "КТИПМ", Новосибирск; ² Новосибирский государственный университет, Новосибирск; ³ Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск; ⁴ Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.</p>
$10^{30} - 10^{45}$	<p><u>Ф.А.Минаков</u>, А.А.Мамрашев, В.Д.Анцыгин, Н.А.Николаев.</p> <p>Поляризационно-чувствительная терагерцовая спектроскопия анизотропных кристаллов.</p> <p>Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.</p>
$10^{45} - 11^{00}$	<p><u>В.Н.Федоринин</u>¹, С.А.Кузнецов^{1,2}, А.В.Гельфанд¹, А.Ю.Горшков¹.</p> <p>Эллипсометрия субмиллиметрового диапазона в задачах диагностики композиционных материалов.</p> <p>¹ Новосибирский филиал ИФП СО РАН "КТИПМ", Новосибирск; ² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.</p>
$11^{00} - 11^{30}$	Кофе-брейк

5-е заседание Председатель – Сидоров Г.Ю.

11³⁰ – 12⁰⁰ **М.В.Якунин**¹, С.М.Подгорных¹, А.В.Суслов²,
С.С.Криштопенко³, B.Jouault³, W.Desrat³, F.Teppe³,
В.Н.Неверов¹, М.Р.Попов¹, Н.Н.Михайлов⁴,
С.А.Дворецкий⁴.

Исследования энергетического спектра
квазидвумерных структур HgTe/CdHgTe
магнитотранспортными методами (**приглашенный доклад**).

¹ *Институт физики металлов им. М.Н. Мухеева
УрО РАН, Екатеринбург;*

² *National High Magnetic Field Laboratory, Florida State
University, Tallahassee, Florida, USA;*

³ *Laboratoire Charles Coulomb, Centre National de la
Recherche Scientifique, University of Montpellier,
Montpellier, France;*

⁴ *Институт физики полупроводников им. А.В.
Ржанова СО РАН, Новосибирск.*

12⁰⁰ – 12¹⁵ **Д.В.Горшков**, В.С.Варавин, Г.Ю.Сидоров,
В.Г.Ремесник, И.В.Сабина.

Восстановление р-типа проводимости HgCdTe после
плазмохимического травления при низких
температурах.

*Институт физики полупроводников им. А.В.
Ржанова СО РАН, Новосибирск.*

12¹⁵ – 12³⁰ **А.В.Кацюба**¹, А.В.Двуреченский^{1,2}, Г.Н.Камаев¹,
В.А.Володин^{1,2}.

Формирование пленки CaSi₂ в условиях
радиационного воздействия на структуру CaF₂/Si.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В.
Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет,
Новосибирск.*

12³⁰ – 12⁴⁵ **Д.М.Ежов**, Е.С.Савельев, Е.Д.Фахрутдинова,
В.А.Светличный.

Использование магнитных наночастиц в устройствах
управления ТГц излучением.

Томский государственный университет, Томск.

- 12⁴⁵ – 13⁰⁰ *В.В.Васильев, **А.В.Вишняков**, Г.Ю.Сидоров,
В.А.Стучинский.*
Определение частотно-контрастной характеристики
ИК объективов.
*Институт физики полупроводников им. А.В.
Ржанова СО РАН, Новосибирск.*
- 13⁰⁰ – 13¹⁵ ***М.В.Дорохин**¹, М.В.Ведь¹, П.Б.Дёмин¹,
Д.В.Хомицкий¹, К.С.Кабаев¹, F.Iikawa², M.A.G.Balanta²,
Б.Н.Звонков¹*
Циркулярно-поляризованная фотолюминесценция в
наноструктурах InGaAs/GaAs, дельта-легированных
Mn.
¹ *Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород;*
² *Instituto de Fisica “Gleb Watagin”, Campinas, Brazil*
- 13¹⁵ – 14³⁰ Обед

6-е заседание Председатель – Морозов С.В.

- 14³⁰ – 15⁰⁰ ***М.М.Глазов***
Экситоны и трионы в оптическом отклике двумерных
кристаллов (**приглашенный доклад**).
*Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе,
Санкт-Петербург.*
- 15⁰⁰ – 15³⁰ ***С.В.Гапоненко***
Перспективы коллоидной оптоэлектроники
(**приглашенный доклад**) (**on-line**).
*Институт физики им. Б. И. Степанова НАН
Беларуси, Беларусь*
- 15³⁰ – 15⁴⁵ ***В.С.Попов**^{1,2}, В.П.Пономаренко^{1,2}, П.И.Абрамов¹.*
Фотоэлектроника на основе коллоидных
наноматериалов.
¹ *Государственный научный центр РФ АО «НПО
«Орион», Москва;*
² *Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет),
Долгопрудный.*

- 15⁴⁵ – 16⁰⁰ **А.С.Голтаев**¹, А.М.Можаров¹, В.В.Ярошенко²,
Д.А.Зуев², И.С.Мухин¹.
Исследование однофотонной излучающей системы
на основе NV-центров в наноалмазах,
интегрированных с ННК GaP.
¹ Академический университет им. Ж.И. Алфёрова,
Санкт-Петербург;
² ИТМО, Санкт-Петербург.
- 16⁰⁰ – 16¹⁵ **В.А.Холоднов**^{1,2}.
О возможности регулирования фотоэлектрического
отклика полупроводников специальным
пространственным профилированием потока
излучения. (on-line)
¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А.
Котельникова РАН, Москва;
² ОАО «НПО «Орион», Москва.
- 16¹⁵ – 16³⁰ Кофе-брейк
- 16³⁰ – 18³⁰ **Стендовая сессия - 2**